



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-163955

(43)Date of publication of application: 25.06.1990

(51)Int.CI.

H01L 23/373 CO1B 31/06 H01L 23/14

(21)Application number: 63-319241

(71)Applicant:

TEKUNISUKO:KK

(22)Date of filing:

17.12.1988

(72)Inventor:

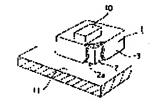
**SEKIYA SHINJI** 

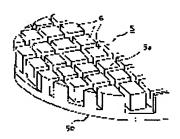
### (54) COATING-TYPE HEAT SINK AND ITS MANUFACTURE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To reduce an amount of diamonds used and to obtain this heat sink which can be worked easily by a method wherein a base body forming a solid body of a required shape is provided and a diamond film is formed on all faces excluding one face of the base body.

CONSTITUTION: A base body 2 forming a solid body of a required shape such as a nearly rectangular parallelepiped shape, a cylindrical shape or the like is provided; a diamond film 3 is formed on all faces excluding one face 2a of the base body 2. A plurality of protrusion parts 6 whose upper faces are flat are formed on one face of a substrate 5 by a grinding means, an embossing means or the like; coating faces 5a are formed; diamond films are formed on the coating faces by a vapor growth means or the like. After that, a grinding operation is executed from the other face 5b, where the diamond coating is not formed, of the substrate 5; the protrusion parts 6 are separated into each piece as the base body 2; a heat sink 1 where the diamond film 3 has been formed on all faces excluding the face 2a of the base body 2 is formed.





### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-163955

@Int. Cl. "

識別記号 庁

С

❸公開 平成2年(1990)6月25日

H 01 L 23/373 C 01 B 31/06 H 01 L 23/14 庁内整理番号

8821-4G

6412-5F H 01 L 23/36 7738-5F 23/14 M

審査請求 未請求 請求項の数 2 (

(全5頁)

分発明の名称

被覆型ヒートシンク及びその製造方法

②特 顧 昭63-319241

出 顧 昭63(1988)12月17日

伊 明 寄 関 家

臣 二 東京都品川区東品川3丁目25番21号 株式会社テクニスコ

内

勿出 顧 人 株式会社テクニスコ

東京都品川区東品川3丁目25番21号

四代 理 人 弁理士 秋元 輝雄 外1名

#### 明 様 書

### 1.発明の名称

彼覆型ヒートシンク及びその製造方法

### 2. 特許請求の範囲

- (1) 略度方体形状或は円質状等の所要形状の立体 を成す基体を有し、この基体の一面を除く他の 全ての面にはダイヤモンド被談が形成されてい ることを特徴とする被復盟ヒートシンク。
- ② 基板の一方の面に研削あるいは型弦などの手段で上面が平坦な複数の突出部を形成して複複面とし、験被理面に気相成異などの手段によりダイヤモンド被観を形成した後に、前記基板のダイヤモンド被観されていない他の一方の面から研削を行うことで前記基体の一面を除く他の全ての面にダイヤモンド被蔑が形成されたヒートンクを形成することを特徴とする被理型ヒートシンクの製造方法。

### 3. 発明の詳細な説明

### 【産業上の利用分野】

本発明は、例えばレーザーダイオードなどの半 単体チャプを延復などにマウントするときに使用 される特に再熱伝導性のヒートシンクに関するも のである。

### 【従来の技術】

従来の、この種のヒートシンク21の例を示すものが第6間であり、レーザーダイオード、インパットダイオードなど高出力の半導体チップ10のケーシング11などへのマウント時においては、防紀半導体チップ10の発熱量が膨大であるために、あらゆる物質中で最も熱伝導率の高いダイヤモンドをヒートシンク21として使用するものであり、これにより前記半導体チップ10の発熱を高い効率で防紀ケーシング11に伝達し冷却効果を高めるものである。 この作用により、この側のヒートシンク21はヒートスプレッダーと称される場合もある。

・【発明が解決しようとする課題】

### 特別平2-163955(3)

直方体形状のものを使用していたのに対し、基体 4として円質状としたもので、ダイヤモンド被属 3が被膜として形成される(次項の製造方法も参 船)ものであるので、このように如何なる形状の ヒートシンク1も所要形状の立体に形成可能であ ることを示すものである。 尚、この実施例の作 用効果は前の実施例と全くに同様であるので、こ こでの詳細な短明は省略する。

つぎに、上記録成としたヒートシンク1の製造 方法について説明する。

第3回に示すものは基板5であり、この基板5の一方の面には、この基板5が全異都材など加工性の高いものであれば切削加工などの運宜の手段で緩破に所定間隔の一定衆さの誘加工を施すことで、複数の突起部8が形成されて被覆面5aとされ、他の一方の面は無加工の平板状とされ返接面5bとされている。

尚、前記基板5を形成する即材がセラミックスなど加工性の低い部材であるとき、政は前記突起 88の平面形状が円形など切削加工で形成するこ

ヤモンド被理されていない連接面5 b から、例えばカップ状の砥石 1 2 などにより前記した機加工の深さまで連する研磨加工が施され(第 4 図参照)、前記突起部6 の夫々が個々に分配されるものとなる。

この研磨加工のときには、例えば図示のように作数チーブル13上に前記器板5の放復面5aを対峙させ、ワックス14で接着しておくことで前記研加工は移品に行えるものとなり、且つ前記した初加工の輝きまで達した後にも突起略8の飛放などの不び合は生じない。

このようにして得られた夫々のダイヤモンド被 世でか成された突起都らは、即ち本発明のヒート シンク1であり、前記基体2にはこの説明におけ る突起部らが対応し、前記ダイヤモンド被覆3に は同様なダイヤモンド被覆7が対応するものとな り、依って前記した研磨加工が行われた面のみが ダイヤモンド被覆3が確されないものとなる。

ここで、前記した研盟加工に付いて特に説明を 加えれば、この研磨加工の大部分が前記基板5に とが囚難などもには型換しなどの手段で的記奏超 感らを形成しても良い。

以上に説明したように形成された基板の一方の面、即ち、突起部らが形成された被覆面らa 似には、例えば気相成長法などによりダイヤモンド被逐7が形成される。 このダイヤモンド接続であるための気相成長法は、熱フィラメントでメタン1(CHa)と水素(Ha)気体を分解しケイと、1、CHa)と水素(Ha)気体を分解しなっては前配基板5に対して導電性を要求するものもるので、その場合には基板5例で素材の選択など適宜に対応させれば良い。

以上の方法で得られた基板5を示すものが第4 図であり、現在の気相成長法の一般的な技術水準では直径略50mmの基板5の建板面5mの全面に対し均一な厚きのダイヤモンド被覆7が形成可能であり、その成長速度は100μm/毎時程度である。

次いで、この基据5の他の一方の面、即ちダイ

対して行われ、加工の困難なダイヤモンド被型7 に対する研磨加工は極短区間であるので比較的に 容易であり、且つ短時間で終了させることが可能 である。

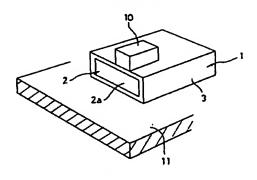
尚、ヒートシンク1のケーシング11上への設定状態は第1回に示すものに限らず、例えば第5回に示すようにダイヤモンド被覆7が行われた一側面をケーシング11に接触させても良いものである。

### 【発明の効果】

以上に説明したようにはダイヤモンドはほが形成されている被覆型とートシンクとしたことで、ダイヤモンド被覆の高い熱伝導性により放熱性を飛四的に高め性能を向上させると云う極めて優れた効果を奏し、でに、一方の面、即ち被覆面にダイヤモンド被覆を遊した後に、他の一方の面、即ちびはでないないないであるがいないないであるがある。

# 特開平2-163955(5)





第6図

